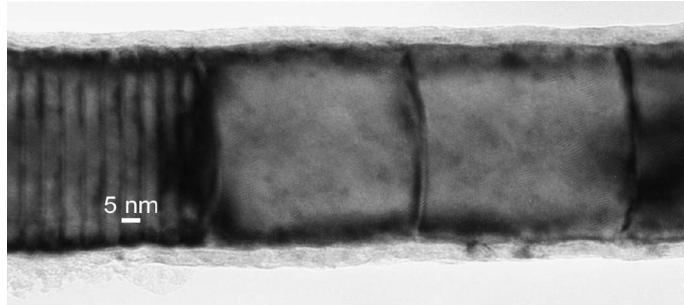


COMPTES RENDUS

PHYSIQUE

Tome 6 (2005) – N° 9



Transmission electron microscopy image of a magnetic multilayered nanowire (see, on the left side, the stack of 1.5 nm thick copper and 4 nm thick cobalt layers). The diameter of the nanowire is about 60 nm. This type of multilayered nanowire is fabricated by electrodeposition of copper and cobalt into the pores of a polycarbonate membrane. It is used for giant magnetoresistance measurements with the current (along the wire) perpendicular to the layers (courtesy of J.-L. Maurice, UMR CNRS/Thales, Palaiseau).

Image d'un nanofil stratifié obtenue en microscopie électronique en transmission. Dans la partie gauche, on voit l'empilement de couches de cuivre (épaisseur 1,5 nm) et de cobalt (4 nm). Le diamètre du fil est d'environ 60 nm. Ce type de nanofil est fabriqué par déposition électrolytique de cuivre et cobalt dans des pores de membrane. Il est utilisé pour des expériences de magnétorésistance géants en courant perpendiculaire aux couches (image de J.-L. Maurice, UMR CNRS/Thales, Palaiseau).

DOSSIER

Spintronics / Spintronique

Guest editors / Rédacteurs en chef invités : Albert Fert, Jean-Pierre Nozières

• Foreword Albert Fert, Jean-Pierre Nozières	919
• Magnetism in reduced dimensions Olivier Fruchart, André Thiaville	921
• Quantum nanomagnet Bernard Barbara	934
• Spin dependent transport: GMR & TMR Alain Schuhl, Daniel Lacour	945
• Spin Transfer Torque: a new method to excite or reverse a magnetization Vincent Cros, Olivier Boulle, J. Grollier, Amir Hamzić, M. Muñoz, Luis Gustavo Pereira, Frédéric Petroff	956
• Spintronic with semiconductors Jean-Marie George, Marc Elsen, V. Garcia, Henri Jaffrès, Richard Mattana	966
• Development of new materials for spintronics Joël Cibert, Jean-François Bobo, Ulrike Lüders	977

Sommaire (suite)

- Magnetic recording read head sensor technology
Jeffrey R. Childress, Robert E. Fontana Jr. 997
- Non-volatile magnetic random access memories (MRAM)
Ricardo C. Sousa, I. Lucian Prejbeanu 1013
- Spin injection into semiconductors: towards a semiconductor-based spintronic device
Ahmad Bsiesy 1022